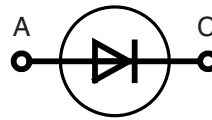
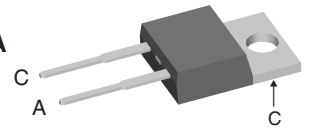
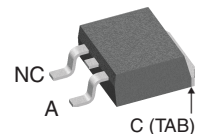


Fast Recovery Epitaxial Diode (FRED)

 $I_{FAV} = 8 \text{ A}$
 $V_{RRM} = 600 \text{ V}$
 $t_{rr} = 35 \text{ ns}$

V_{RSM}	V_{RRM}	Type
V	V	
640	600	DSEI 8-06A
640	600	DSEI 8-06AS


TO-220 AC
DSEI 8-06A

TO-263 AB
DSEI 8-06AS


A = Anode, C = Cathode,
 NC = No Connection,
 TAB = Cathode

Symbol	Conditions	Maximum Ratings		
I_{FRMS}	$T_{VJ} = T_{VJM}$	16	A	
I_{FAVM} ①	$T_C = 115^\circ\text{C}$; rectangular, $d = 0.5$	8	A	
I_{FRM}	$t_p < 10 \mu\text{s}$; rep. rating, pulse width limited by T_{VJM}	130	A	
I_{FSM}	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$;	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	100	A
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	110	
	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$;	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	85	A
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	95	
I^2t	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$;	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	50	A^2s
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	50	
	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$;	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	36	A^2s
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	37	
T_{VJ}		-40...+150	$^\circ\text{C}$	
T_{VJM}		150	$^\circ\text{C}$	
T_{stg}		-40...+150	$^\circ\text{C}$	
P_{tot}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	50	W	
M_d	mounting torque	0.4...0.6	Nm	
Weight	typical	2	g	

Features

- International standard package JEDEC TO-220 AC & TO-283 AB
- Planar passivated chips
- Very short recovery time
- Extremely low switching losses
- Low I_{RM} -values
- Soft recovery behaviour
- Epoxy meets UL 94V-0

Applications

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Anti saturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode in converters and motor control circuits
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Inductive heating and melting
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Ultrasonic cleaners and welders

Advantages

- High reliability circuit operation
- Low voltage peaks for reduced protection circuits
- Low noise switching
- Low losses
- Operating at lower temperature or space saving by reduced cooling

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		typ.	max.	
I_R	$V_R = V_{RRM}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	20	μA
	$V_R = 0.8 \cdot V_{RRM}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	10	μA
	$V_R = 0.8 \cdot V_{RRM}$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$	1.5	mA
V_F	$I_F = 8 \text{ A}$	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$	1.3	V
		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.5	V
V_{T0}	For power-loss calculations only		0.98	V
r_T	$T_{VJ} = T_{VJM}$		28.7	m Ω
R_{thJC} R_{thCH} R_{thJA}		0.5	2.5	K/W
				K/W
			60	K/W
t_{rr}	$I_F = 1 \text{ A}$; $-di/dt = 50 \text{ A}/\mu\text{s}$; $V_R = 30 \text{ V}$; $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	35	50	ns
I_{RM}	$V_R = 350 \text{ V}$; $I_F = 8 \text{ A}$; $-di_F/dt = 64 \text{ A}/\mu\text{s}$ $L \leq 0.05 \mu\text{H}$; $T_{VJ} = 100^\circ\text{C}$	2.5	2.8	A

① I_{FAVM} rating includes reverse blocking losses at T_{VJM} . $V_R = 0.8 \cdot V_{RRM}$, duty cycle $d = 0.5$
 Data according to IEC 60747

IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

20090106a

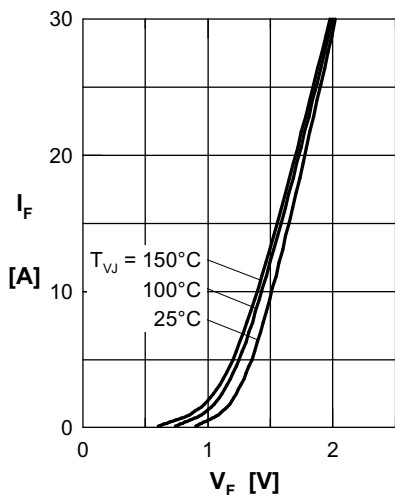


Fig. 1 Forward current I_F versus V_F

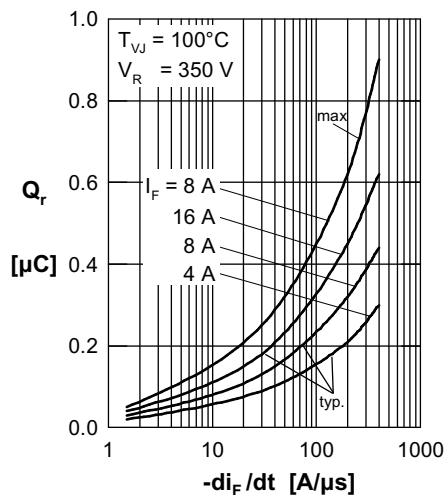


Fig. 2 Typ. reverse recov. charge Q_r versus $-di_F/dt$

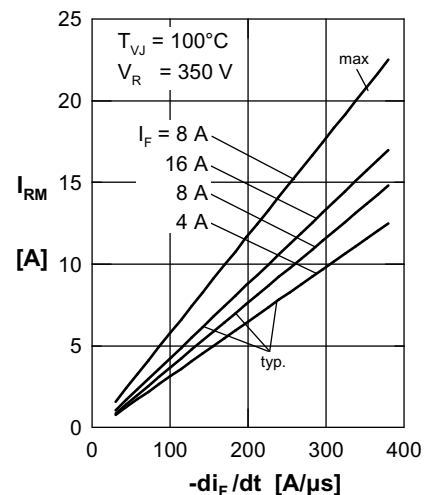


Fig. 3 Typ. peak reverse current I_{RM} versus $-di_F/dt$

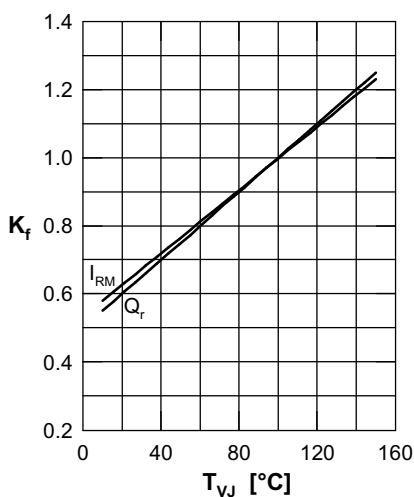


Fig. 4 Dyn. parameters Q_r , I_{RM} versus T_{VJ}

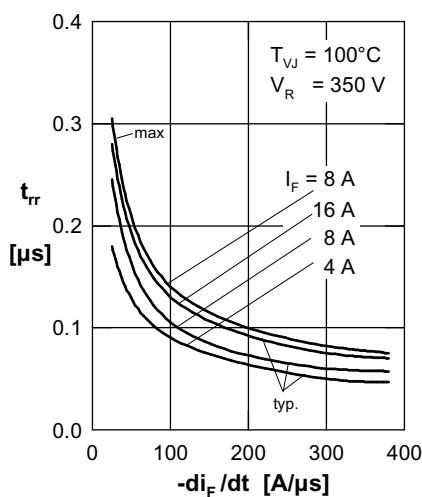


Fig. 5 Typ. recovery time t_{rr} versus $-di_F/dt$

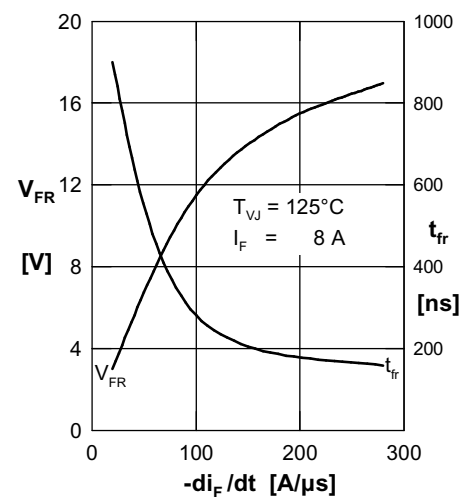


Fig. 6 Typ. peak forward voltage V_{FR} and t_{fr} versus di_F/dt

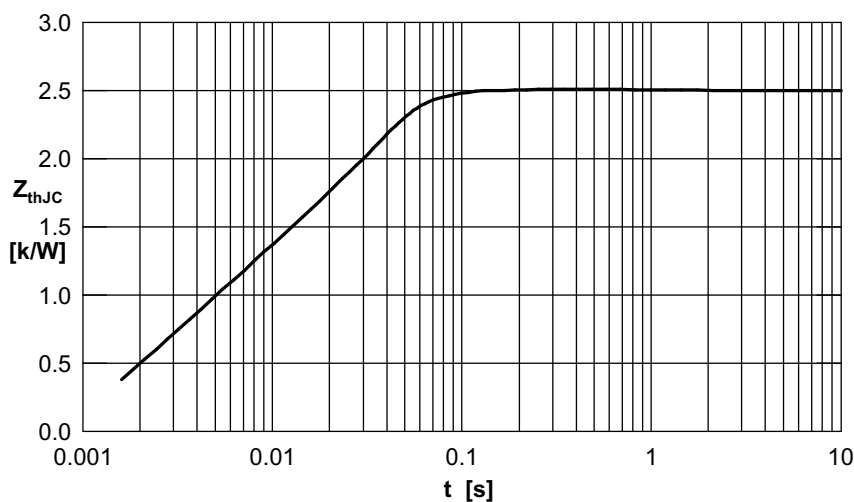
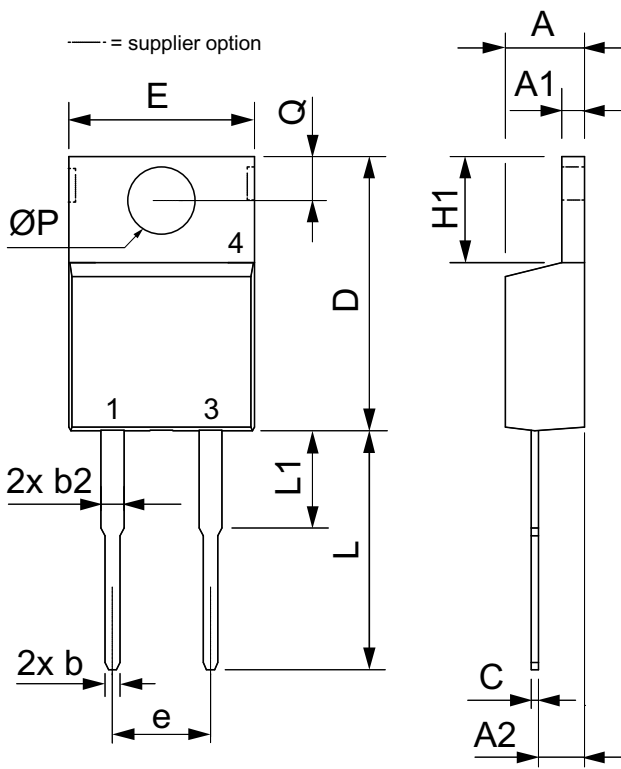


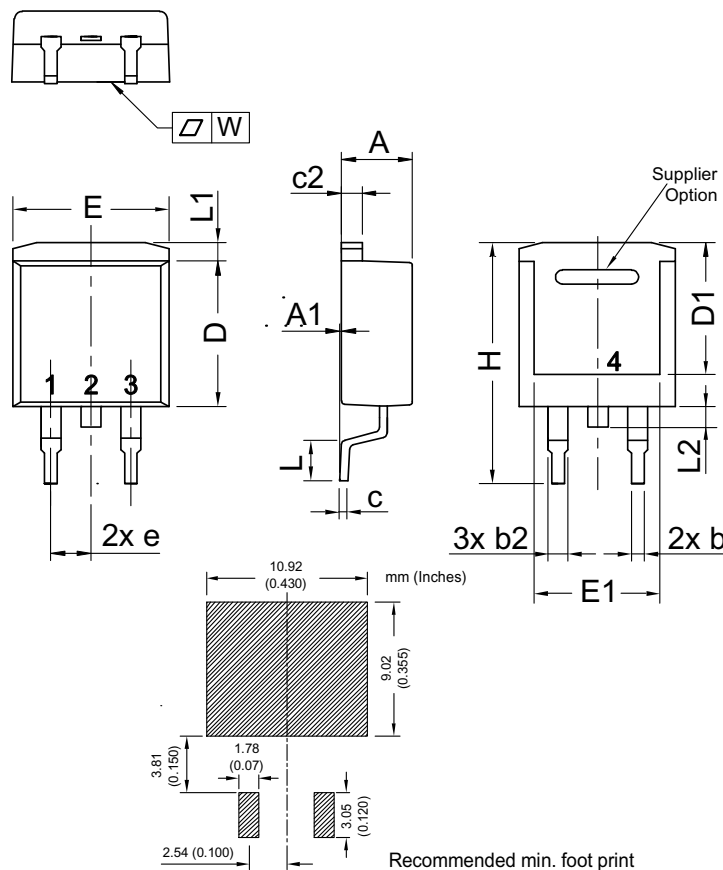
Fig. 7 Transient thermal impedance junction to case

Dimensions TO-220 AC



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.32	4.82	0.170	0.190
A1	1.14	1.39	0.045	0.055
A2	2.29	2.79	0.090	0.110
b	0.64	1.01	0.025	0.040
b2	1.15	1.65	0.045	0.065
C	0.35	0.56	0.014	0.022
D	14.73	16.00	0.580	0.630
E	9.91	10.66	0.390	0.420
e	5.08	BSC	0.200	BSC
H1	5.85	6.85	0.230	0.270
L	12.70	13.97	0.500	0.550
L1	2.79	5.84	0.110	0.230
ØP	3.54	4.08	0.139	0.161
Q	2.54	3.18	0.100	0.125

Dimensions TO-263 AB



Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.06	4.83	0.160	0.190
A1	typ. 0.10		typ. 0.004	
A2	2.41		0.095	
b	0.51	0.99	0.020	0.039
b2	1.14	1.40	0.045	0.055
c	0.40	0.74	0.016	0.029
c2	1.14	1.40	0.045	0.055
D	8.38	9.40	0.330	0.370
D1	8.00	8.89	0.315	0.350
D2	2.5		0.098	
E	9.65	10.41	0.380	0.410
E1	6.22	8.50	0.245	0.335
e	2.54 BSC		0.100 BSC	
e1	4.28		0.169	
H	14.61	15.88	0.575	0.625
L	1.78	2.79	0.070	0.110
L1	1.02	1.68	0.040	0.066
W	typ. 0.02	0.040	typ. 0.0008	0.002

All dimensions conform with and/or within JEDEC standard.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.